

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре $(25 \pm 5)^\circ \text{C}$			
Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		140УД14СВК, 140УД14С1ВК, 140УД1401СВК, 140УД1401С1ВК, ОСМ140УД14С1ВК, ОСМ140УД1401С1ВК	
		Не менее	не более
Максимальное выходное напряжение, В	$U_o \max$	13,0	-13,0
Напряжение смещения нуля, мкВ	$U_{ю}$	-2,0	2,0
Входной ток, нА	I_i	-2,0	2,0
Разность входных токов, нА	$I_{ю}$	-0,2	0,2
Ток потребления, мА	I_{cc}	-0,6	0,6
Коэффициент усиления напряжения	A_u	50000	-
<p>Режим измерения – при: $U_{cc} = \pm 15 \text{ В}; R_L = 10 \text{ кОм}$</p> <p>Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: - золото</p> <p>Цветных металлов не содержится.</p>			

НАДЕЖНОСТЬ
<p>Минимальная наработка (T_{nm}) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных режимах при: $U_{cc} = \pm(15 \pm 0,15) \text{ В}; R_L = 10 \text{ кОм} - 120000 \text{ ч}$</p> <p>Гамма-процентный ресурс (T_{γ}) микросхем при $\gamma = 95\%$ 200000 ч</p> <p>Минимальный срок сохраняемости микросхем ($T_{см}$) при их хранении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет; - в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет; - под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет. <p>Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.</p>
<p>ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</p> <p>Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431130.171-11ТУ, а микросхем с индексом “ОСМ” - АЕЯР.431130.171-11ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.</p> <p>Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.</p>